



《风光欣》技术资料

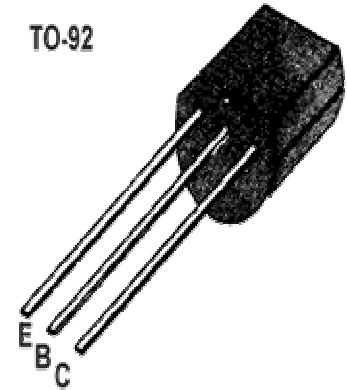
S 9015

PNP EPITAXIAL SILICON TRANSISTOR

主要用途:通用放大、开关等。

绝对最大额定值 (Ta=25)

项 目	符号	额定值	单位
集电极-基极电压	V _{CB0}	-50	V
集电极-发射极电压	V _{CEO}	-45	V
发射极-基极电压	V _{EB0}	-5	V
集电极电流	I _c	-100	mA
集电极耗散功率	P _c	450	mW
结 温	T _J	150	
存储温度	T _{STG}	-55 ~150	



电参数 (Ta=25)

项 目	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
集电极-基极击穿电压	BV _{CB0}	I _c = -100 μ A, I _E =0	-50			V
集电极-发射极击穿电压	BV _{CEO}	I _c = -1mA, I _B =0	-45			V
发射极-基极击穿电压	BV _{EB0}	I _E = -100 μ A, I _c =0	-5			V
集电极-基极截止电流	I _{CB0}	V _{CB} = -50V, I _E =0			-50	nA
发射极-基极截止电流	I _{EB0}	V _{EB} = -5V, I _c =0			-50	nA
直流电流增益	h _{FE}	V _{CE} = -5V, I _c = -1mA	60	200	600	
集电极-发射极饱和压降	V _{CE(sat)}	I _c = -100mA, I _B = -5mA		-0.2	-0.7	V
基极-发射极饱和压降	V _{BE(sat)}	I _c = -100mA, I _B = -5mA		-0.82	-1.0	V
基极-发射极电压	V _{BE(on)}	V _{CE} = -5V, I _c = -2mA	-0.6	-0.65	-0.75	V
共基极输出电容	C _{OB}	V _{CB} = -10V, I _E =0, F=1MHZ		4.5	7.0	pF
电流增益-带宽乘积	f _T	V _{CE} = -5V, I _c = -10mA	100	190		MHz
噪音系数	NF	V _{CE} = -5V, I _c = -0.2mA		0.70	10.0	dB
		f=1KHz, R _s =1K				

Hfe 分档及其标志

分档	A	B	C
H _{FE}	60~150	100~300	200~600